

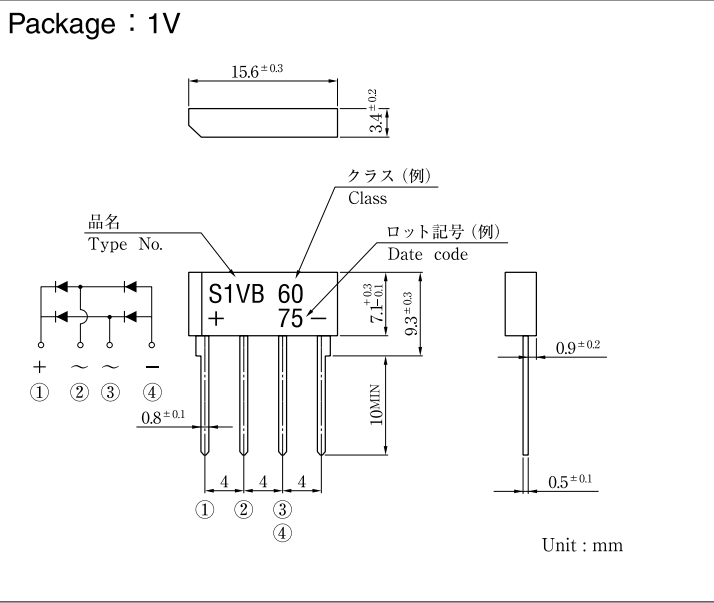
S1VB□

800V 1A

特長

- SIPパッケージ
- 自動実装対応

外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS



(製品上の表示については、捺印仕様をご確認ください)

定格表 RATINGS

●絶対最大定格 Absolute Maximum Ratings (指定のない場合 $T_l = 25^{\circ}\text{C}$)

項 目 Item	記号 Symbol	条 件 Conditions	品 名 Type No.			単位 Unit
			S1VB□			
			20	60	80	
保存温度 Storage Temperature	Tstg		- 40～150			℃
接合部温度 Operating Junction Temperature	Tj		150			℃
せん頭逆電圧 Maximum Reverse Voltage	VRM		200	600	800	V
出力電流 Average Rectified Forward Current	IO	50Hz 正弦波, 抵抗負荷, プリント基板実装, Ta=25℃ 50Hz sine wave, R-load, On glass-epoxy substrate, Ta=25℃	1			A
せん頭サージ順電流 Peak Surge Forward Current	IFSM	50Hz 正弦波, 非繰り返し1サイクルせん頭値, Tj=25℃ 50Hz sine wave, Non-repetitive 1cycle peak value, Tj=25℃	30			A
電流二乗時間積 Current Squared Time	I²t	1ms ≤ t < 10ms Tj=25℃	4.5			A²s

●電氣的・熱的特性 Electrical Characteristics (指定のない場合 $T_l = 25^{\circ}\text{C}$)

順電圧 Forward Voltage	V_F	$I_F = 0.5\text{A}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	1.05	V
逆電流 Reverse Current	I_R	$V_R = V_{\text{RM}}$, パルス測定, 1素子当りの規格値 Pulse measurement, Rating of per diode	MAX	10	μA
熱抵抗 Thermal Resistance	θ_{jl}	接合部・リード間 Between junction and lead	MAX	16	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
	θ_{ja}	接合部・周囲間 Between junction and ambient	MAX	62	

特性図 CHARACTERISTIC DIAGRAMS

